

Тематический указатель статей, опубликованных в 2013 году

Материалы электронной техники

- Вигдорович Е.Н.* Метастабильное состояние системы CdTe–HgTe. № 3(101), с. 3.
- Гончаров В.А., Дормидонтов А.Н.* Численное моделирование влияния нестационарных условий на образование концентрационных полос роста при выращивании кристаллов методом Бриджмена. № 6(104), с. 3.
- Козюхин С.А., Шерченков А.А., Бабич А.В.* Фазовое разделение в халькогенидных полупроводниках системы Ge–Te при термоциклировании. № 2(100), с. 3.
- Кореновский Н.Л., Петров В.С., Полунина А.А., Гайдар А.И., Столяров В.Л., Васильевский В.В., Монахов И.С., Ключева Н.Е.* Композитный материал на основе пористого титана для селективного поглощения водорода из газовых смесей. № 2(100), с. 9.
- Яковлев В.Б., Бардушкин В.В., Лавров И.В., Яковлева Е.Н.* Моделирование частотной дисперсии эффективных диэлектрических характеристик композиционных материалов. № 3(101), с. 7.

Технология микро- и нанoeлектроники

- Блинов Г.А., Борисов А.Г., Любимов А.В.* Технология фольгированного полиимида для плоских электромагнитных компонентов. № 4(102), с. 13.
- Бобовников П.Г., Ермаков А.С., Матюшкин И.В., Орлов С.Н., Свечкарев К.П., Шелепин Н.А., Михайлов А.Н., Белов А.И.* Автоэмиссия из наноструктур на основе карбида кремния и влияние на нее образующихся субоксидных SiO_x-покрытий. I. Конструктивно-технологические особенности SiC-микрокатодов. Обзор. № 4(102), с. 3.
- Бобовников П.Г., Ермаков А.С., Матюшкин И.В., Орлов С.Н., Свечкарев К.П., Шелепин Н.А., Михайлов А.Н., Белов А.И.* Автоэмиссия из наноструктур на основе карбида кремния и влияние на нее образующихся субоксидных SiO_x-покрытий. II. Эмиссионные свойства SiC-нанопротрузий. Обзор. № 5(103), с. 3.
- Долгий Л.Н., Ловшенко И.Ю., Нелаев В.В.* Технология формирования и электрические характеристики полевого датчика Холла на основе КНИ-структуры. № 1(99), с. 3.
- Кислицин М.В., Королёв М.А., Красюков А.Ю.* Исследование процесса формирования пленки оксида кремния из раствора тетраэтоксисилана золь-гель методом. № 2(100), с. 17.
- Короткий О.В.* Особенности объемного планирования в задаче автоматизированного управления мелкосерийным производством микросхем. № 3(101), с. 16.
- Новак А.В.* Формирование пленок поликристаллического кремния с полусферическими зернами для конденсаторных структур с повышенной емкостью. № 6(104), с. 10.
- Яремчук А.Ф., Старков А.В., Заикин А.В., Алексеев А.В., Соколов Е.М.* Применение методики поверхностной фотоЭДС для контроля качества кремниевых эпитаксиальных слоев на сапфире. № 5(103), с. 14.

Микроэлектронные приборы и системы

- Белюсов Е.О., Тимошенко А.Г.* Метод расширения полосы пропускания усилителей с переменным коэффициентом усиления. № 4(102), с. 24.
- Быстрицкий С.А., Клюкин В.И., Бормонтов Е.Н.* Кольцевой генератор, управляемый напряжением, для высокоскоростных систем ФАПЧ. № 6(104), с. 17.
- Вернер В.Д., Луканов Н.М., Сауров А.Н.* СВЧ-самосовмещенные структуры с прямыми и обращенными ультратонкими эмиттерными областями. № 3(101), с. 21.

- Кузнецов Е.В., Рязанцев Д.В.** Моделирование вторичного пробоя латерального ДМОП-транзистора при облучении. № 4(102), с. 18.
- Литвиненко Р.С., Гусев Д.В., Суханов В.С.** Особенности построения многоканальных силовых интеллектуальных модулей. № 5(103), с. 35.
- Лосев В.В., Крупкина Т.Ю., Чаплыгин Ю.А.** Схемотехнические способы реализации метода импульсной подкачки мощности в многофазных адиабатических драйверах резонансного типа. № 6(104), с. 24.
- Риттер А.В., Чебышов С.Б.** Метод расчета источника тока промышленной частоты, выполненного с применением электромеханических реле. № 5(103), с. 27.
- Романюк В.А., Аунг Бо Бо Хейн.** Применение удвоителя частоты на двух транзисторах для гетеродина смесителя. № 4(102), с. 28.
- Стенин В.Я.** Моделирование переходных характеристик суб-100-нм КМОП двухфазных инверторов при локальном воздействии ядерной частицы. № 2(100), с. 23.
- Тарасов С.А., Александрова О.А., Максимов А.И., Мараева Е.В., Матюшкин Л.Б., Менькович Е.А., Мошников В.А., Мусихин С.Ф.** Исследование процессов самоорганизации квантовых точек сульфида свинца. № 3(101), с. 28.
- Тимошенко С.П., Нальский А.А., Касатов Д.А., Водопьянов В.А.** Разработка конструкции источника тока на термоэлектрическом эффекте с повышенными показателями эффективности. № 5(103), с. 20.
- Штерн Ю.И., Кожевников Я.С., Рыков В.М., Миронов Р.Е.** Математические модели и аппаратно-программные средства для высокоточных электронных измерителей температуры. № 1(99), с. 10.

Нанотехнология

- Белов А.Н., Гаврилин И.М., Гаврилов С.А., Дронов А.А., Лабунов В.А.** Влияние активности фторсодержащих электролитов на достижение максимальной толщины пористого анодного оксида титана. № 2(100), с. 49.
- Бобринецкий И.И., Емельянов А.В., Неволин В.К., Ромашкин А.В.** Влияние покрытия молекулами органических соединений на управление проводимостью канала из углеродных нанотрубок. № 4(102), с. 51.
- Бобринецкий И.И., Комаров И.А., Лаврентьев К.К., Левин Д.Д., Симунин М.М., Неволин В.К., Квачева Л.Д., Червонобродов С.П., Буриан А., Хавелек Л., Возница Н.** Особенности интеграции графенов в технологические процессы микроэлектроники. № 3(101), с. 33.
- Бобринецкий И.И., Морозов Р.А., Трошин В.В., Чаплыгин Е.Ю.** Атомно-силовая микроскопия биологических наночастиц на воздухе. № 2(100), с. 36.
- Булярский С.В., Лакалин А.В., Басаев А.С.** Методика расчета тока автоэмиссии из одиночной углеродной нанотрубки. № 1(99), с. 18.
- Гаврилов С.А., Громов Д.Г., Дубков С.В., Назаркин М.Ю., Силибин М.В., Тимошенко С.П., Козьмин А.М., Шулятьев А.С.** Исследование колебаний пьезоэлектрического элемента на основе нанопроволок ZnO и пористого электрода. № 4(102), с. 44.
- Галперин В.А., Жуков А.А., Павлов А.А., Скорик С.Н., Шаман Ю.П., Шаманаев А.А.** Влияние морфологии массивов УНТ на плотность тока матриц автоэлектронных эмиттеров. № 5(103), с. 58.
- Галперин В.А., Кицюк Е.П., Скундин А.М., Тусеева Е.К., Кулова Т.Л., Шаман Ю.П., Скорик С.Н.** Разработка электродов на основе композита кремний – углеродные нанотрубки для литиевых аккумуляторов повышенной емкости. № 4(102), с. 38.
- Герасименко Н.Н., Смирнов Д.И., Медетов Н.А., Запорожан О.А.** Влияние размерных эффектов на радиационную стойкость нанокристаллических материалов. № 6(104), с. 31.
- Громов Д.Г., Боргардт Н.И., Волков Р.Л., Галперин В.А., Гришина Я.С., Дубков С.В.** Особенности структуры и свойств углеродных наностолбиков, сформированных низкотемпературным осаждением из газовой фазы. № 2(100), с. 42.

Громов Д.Г., Галперин В.А., Миронов А.Е., Кицюк Е.П., Дубков С.В., Лебедев Е.А., Смирнов В.В. Емкостные свойства конденсаторной структуры с двойным электрическим слоем на основе углеродных нанотрубок и ортофосфорной кислоты. № 6(104), с. 39.

Громов Д.Г., Лебедев Е.А., Смирнов В.В., Шулятьев А.С. Конденсатор с электродом на основе наноструктурированного золота. № 5(103), с. 52.

Громов Д.Г., Шулятьев А.С., Егоркин В.И., Зайцев А.А., Скорик С.Н., Галперин В.А., Павлов А.А., Шаманаев А.А. Формирование массива упорядоченных нанокатодов на основе углеродных нанотрубок методом наноимпринт литографии и процессов ПСХПО. № 3(101), с. 43.

Егоркин В.И., Зайцев А.А., Неволин В.К., Симунин М.М. Формирование кластеров никеля для роста углеродных нанотрубок. № 2(100), с. 33.

Егоркин В.И., Ильичев Э.А., Журавлёв М.Н., Бурзин С.Б., Шмелев С.С. Туннелирование через двухбарьерную туннельно-резонансную гетероструктуру на основе GaN/AlN. № 5(103), с. 65.

Схемотехника и проектирование

Гаврилов В.С., Казённов Г.Г. Метод моделирования асимметричного доступа к памяти при решении задач синхронизации многопроцессорных систем. № 2(100), с. 59.

Заикин А.В. Метод размещения стандартных ячеек СБИС на основе сочетания результатов работы итерационных алгоритмов. № 4(102), с. 32.

Ильин С.А. Тестирование библиотек цифровых ячеек. № 3(101), с. 48.

Кононов А.Н., Миндеева А.А., Петросян В.С. Структурная оптимизация схем микроконвейерной архитектуры, спроектированных в базе стандартных ячеек. № 5(103), с. 41.

Лифшиц В.Б., Агрич Ю.В. Методы и средства отладки динамических параметров быстродействующих АЦП. № 1(99), с. 25.

Старков А.В. Метод оценки искажений топологии для детальной трассировки нанометровых СБИС. № 2(100), с. 54.

Фролов Д.П. Применение метода морфологического синтеза для проектирования реконфигурируемой аналоговой ячейки полузаказных аналого-цифровых СБИС с матричной структурой. № 5(103), с. 45.

Чураев С.О. Использование эффекта накопления фазовой ошибки в кольцевых генераторах для оценки временных параметров цифровых элементов интегральных схем. № 1(99), с. 34.

Микро- и наносистемная техника

Беспалов В.А., Ильичев Э.А., Кулешов А.Е., Набиев Р.М., Петрухин Г.Н., Рычков Г.С. МЭМС-переключатели в радиочастотной электронике. I. Актуальность, проблемы реализации, предварительные оценки. Обзор. № 3(101), с. 64.

Беспалов В.А., Ильичев Э.А., Кулешов А.Е., Набиев Р.М., Петрухин Г.Н., Рычков Г.С. МЭМС-переключатели в радиочастотной электронике. II. Состояние разработок и перспективы. Обзор. № 4(102), с. 61.

Кузнецов Е.В., Чуйко О.В. Исследование чувствительности рН-сенсоров на основе кремниевых МДП-нанотранзисторов. № 3(101), с. 53.

Рыгалин Д.Б., Фетисов Е.А., Хафизов Р.З., Золотарев В.И., Решетников И.А., Рудаков Г.А., Лапшин Р.В., Кириленко Е.П. Перспективные интегральные матричные приемники теплового излучения с оптическим считыванием. № 3(101), с. 60.

Информационные технологии

Амербаев В.М., Тельпухов Д.В. Обратный преобразователь модулярной арифметики с использованием неточного ранга для задач ЦОС. № 1(99), с. 41.

Куденко И.В., Скляр С.В., Шишкевич А.А. Синтез структурной схемы территориально-распределенной информационно-управляющей вычислительной системы реального времени на базе ЛВС Ethernet и EtherCAT. № 6(104), с. 52.

Матвеев В.А. Методы и алгоритмы оптимизации оперативного и календарного планирования производственного процесса сборки и испытаний микросхем. № 6(104), с. 62.

Назаров Л.Е., Зудилин А.С. Алгоритмы компенсации сосредоточенных по спектру помех для сигналов с ортогональным частотным мультиплексированием. № 6(104), с. 45.

Песикова О.В. Необходимые условия системного самодиагностирования многомашинных вычислительных систем. № 1(99), с. 53.

Рыбаков А.А. Анализ алгоритмов оптимизации расположения в памяти линейных участков программы. № 1(99), с. 47.

Соловьев Р.А., Тельпухов Д.В. Аппаратная реализация операции нахождения остатка целочисленного деления для входных данных большой разрядности в модулярной арифметике. № 4(102), с. 75.

Шишкевич А.А. Оценка показателей надежности вычислительных устройств с трехкратным мажорированием при отказах и сбоях. № 4(102), с. 84.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Балабанов А.А., Кузнецов С.Н. Анализ импульсных генераторов с одним реактивным элементом. № 6(104), с. 76.

Горохов С.В., Пименов А.В., Шарамок А.В. Выбор параметров синхронизации системы связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. № 6(104), с. .

Гурарий М.М., Жаров М.М., Русаков С.Г., Ульянов С.Л. Метод анализа режимов синхронизации и биений автогенератора при паразитном возбуждении сигналом произвольной формы и частоты. № 3(101), с. 73.

Ле Тхай Шон, Алексеев Ю.И., Орда-Жигулина М.В. Чувствительность системы автодинного детектирования СВЧ-амплитудно-модулированных оптических сигналов. № 1(99), с. 68.

Пименов А.В. Имитационная модель синхронизации средств связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. № 2(100), с. 66.

Фролов А.В. Анализ параметрической чувствительности схем электрических активных фильтров с положительной обратной связью. № 1(99), с. 60.

Щагин А.В., Чжо Ту, Йе Тун Тэйн. Коррекция коэффициента мощности на IGBT-транзисторах в системе управления трехфазным выпрямителем. № 3(101), с. 82.

Методы и техника измерений

Барабан А.П., Дмитриев В.А., Петров Ю.В., Тимофеева К.А. Диагностика γ -облученных структур Si-SiO₂ методом катодолюминесценции. № 2(100), с. 71.

Печерская Е.А., Соловьёв В.А., Метальников А.М., Вареник Ю.А., Гладков И.М., Рябов Д.В. Контроль временной нестабильности диэлектрических параметров сегнетоэлектриков. № 2(100), с. 84.

Усанов Д.А., Горбатов С.С., Кваско В.Ю. Измерение подвижности и концентрации носителей заряда в арсенид-галлиевом диоде Ганна с помощью ближнеполевого СВЧ-микроскопа. № 2(100), с. 77.

Биомедицинская электроника

Аюпов И.Р., Гончаров В.А., Лукьянов И.В. Нейросетевой метод для прогнозирования состояния больного. № 5(103), с. 75.

Терещенко С.А., Федоров Г.А., Антаков М.А., Бурнаевский И.С. Семейства аппаратных функций гексагональных кодирующих коллиматоров. № 5(103), с. 70.

Проблемы высшего образования

Балабанов А.А., Балабанова Д.А. Генерация и проверка тестовых заданий в приложении MS Excel. № 1(99), с. 73.

Воробьев Н.В. Методика классификации триггеров по функциональному назначению. № 5(103), с. 81.

Краткие сообщения

Алексеев В.Е., Соловьёв А.Н. Определение координат мобильного устройства с помощью сотовой сети. № 1(99), с. 82.

Антаков М.А., Пьянов И.В. Влияние эффекта поляризации света на качество оптических томограмм. № 1(99), с. 81.

Беиенков В.Г., Вяткин А.Ф., Амеличев В.В., Костюк Д.В. Анализ многослойных тонкоплёночных структур методом электронной оже-спектроскопии в условиях перекрывания оже-пиков элементов. № 4(102), с. 89.

Гуляев А.В., Турканов Г.И., Сакилов С.Б., Балашиов А.Г. Построение высоконагруженной информационно-системы с облачным хранилищем данных. № 6(104), с. 92.

Гусев Д.В., Суханов В.С., Земляничков Н.С., Суханова Е.В. Тактильный датчик для эндоскопии на основе матрицы чувствительных элементов давления. № 1(99), с. 88.

Данилов А.А., Корнюхин А.В. Влияние радиуса приемной катушки индуктивности на нагрев биологической ткани при беспроводной передаче энергии с помощью индуктивной связи. № 4(102), с. 92.

Куксов П.А. Влияние фазовой флуктуации сигнала на качество передачи информации. № 5(103), с. 91.

Куксов П.А. Оценка отношения сигнал/шум при разбросе параметров приемопередающих трактов радиосистем. № 3(101), с. 88.

Лавренев В.А., Разживалов П.Н. Влияние термических факторов на точностные характеристики датчика астроориентации. № 2(100), с. 91.

Лосев В.В. Измерение параметров энергопотребления адиабатической логики. № 5(103), с. 89.

Малашевич Н.И. Реализация ячейки ОЗУ в составе КМОП БМК. № 2(100), с. 89.

Неустроев С.А. Определение межатомных расстояний в кристаллах кубического углерода. № 6(104), с. 82.

Неустроев С.А. Электрическая составляющая энергии связи молекулярных орбиталей в тетраэдрах кубического углерода. № 1(99), с. 91.

Петросьянц К.О., Попов Д.А. Учет влияния температуры на радиационный сдвиг порогового напряжения МОП-транзистора в системе TCAD. № 4(102), с. 96.

Петросьянц К.О., Кожухов М.В., Смирнов Д.С. Влияние изохронного и изотермического отжига на процесс восстановления коэффициента усиления по току кремниевого биполярного транзистора, подвергнутого воздействию радиации. № 6(104), с. 85.

Сергеев В.А. Анализ тепловых режимов мощных светодиодов в составе светодиодных излучателей. № 1(99), с. 85.

Терещенко С.А., Титенок С.А. Определение фактора анизотропии рассеивающей среды с помощью метода Монте-Карло. № 2(100), с. 93.

Тин Чжо, В.М.Трояновский, Ян Лин Аунг. Программа верификации данных компьютерного эксперимента. № 6(104), с. 90.

Тихомиров А.А., Краснобородько С.Ю., Шевяков В.И. Методика проведения измерений в полуконтактной моде атомно-силовой микроскопии. № 4(102), с. 94.

Фёдоров Р.А., Росляков А.С. Контрольно-диагностический стенд для проверки функционирования имитаторов БИС на БМК. № 3(101), с. 90.

Щагин А.В., Йе Тун Тэйн. Оптимальное управление нагревом диффузионной установки. № 6(104), с. 87.

Конференции

8 февраля – День российской науки. Мизтовские научные чтения. № 2(100), 3 стр. обложки.

11th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS 2013) (Ростов-на-Дону, Россия, 27–30 сентября 2013 г.). № 1(99), 4 стр. обложки.

20-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика-2013» (Москва, апрель 2013 г.). № 1(99), с. 94.

Об итогах 20-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2013». № 3(101), с. 93.

Юбилеи

Бархоткину Вячеславу Александровичу – 75 лет. № 1(99), с. 95.

Королёву Михаилу Александровичу – 80 лет. № 2(100), с. 96.

Орликовскому Александру Александровичу – 75 лет. № 4(102), с. 98.

Соколову Евгению Борисовичу – 80 лет. № 3(101), с. 92.

Усанову Дмитрию Александровичу – 70 лет. № 4(102), с. 100.

Уважаемые авторы !

Правила оформления рукописей опубликованы на нашем сайте:

<http://www.miet.ru/structure/s/894/e/43021/191>